

94-0008

Invenția se referă la tehnologia semiconductoarelor și poate fi utilizată pentru obținerea prin metoda clorurilor a straturilor epitaxiale AIIIIV cu parametri electrofizici reproductibili.

Pentru perfecționarea calității și reproductibilității parametrilor electrofizici în cadrul procesului de cultivare a straturilor epitaxiale AIIIIV în sistem de cloruri, procesul conținând pregătirea accesoriilor, decaparea chimică, purjarea cu hidrogen a reactorului, termostatarea clorurii, încălzirea sursei și a substraturilor, decaparea chimică a substraturilor, cultivarea straturilor subțiri, se efectuează decaparea gazoasă repetată a stratului cultivat și cultivarea lui ulterioară.

Rezultatul tehnic al invenției propuse constă în perfecționarea calității și reproductibilității parametrilor electrofizici ai straturilor epitaxiale.